# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

### ® 公開特許公報(A) 昭60-195957

@Int\_Cl\_4

識別記号 庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48 23/28 7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 リードフレーム

砂特 願 昭59~50939

| 顧昭59(1984)3月19日

母 発明者 谷川 喬

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

②発明者中沢 洋 小平市上水本町1450番地 株式会社日立 の出 調 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

20代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外1名

#### 明 超 1

発明の名称 リードフレーム

#### 条件数文の無規

1. 偏面に突出部を設けて成ることを併載とする

2. 前記リードフレームがプラステックモールド 用リードフレームである、特許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

#### 発明の評価な説明

#### [ 技管分野 ]

本発明はリードフレームに関し、特に、モールドレジンとの哲療性を良くし、対止性のよい徴取 対止型半導体装置を得ることができるリードフレ ームに関する。

#### 〔背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1 閣に 示すごときものが展知である(工業調査会刊「IC 化実装技術」 P137~P150 など)。第1 図に て、1 は半導体チェブをマウントするタブ、2 は このタブを吊っているタブ吊りリード、3 は半導 体チェブの内部配銀をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード側の電振及 び半導体チェブ側の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の組音波ポンディング法などによりポン ディングして電気的接続を行った後に、樹脂(レ ジン)を周知のトランスフェーモールド法などに より半導体チェブやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂倒止型 の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂割止極半導体装置にあっては、リードフレームとレジンとの物層性を良好にし、射止性(耐優性)を向上させ、信頼度を向上させることが必要であり、近時は半導体チェブの大形化に伴ない、割止巾が増々狭くなっており、これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体装置に使用されるリードフレームにあっては、その質量がフラットに構成されており、リードフレームとレジンとの密着性が不足し、對止性、信頼度の向上という面で問題があることがわかった。

#### 〔発明の目的〕

本発明はリードフレームとレジンとの智慧(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの智力性を良好にし、対止性を向上し、信頼度の高い複雑対止理半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細帯の記述および低付額面からあき らかになるであろう。

#### 【禁制の転要】

本意において開示される発明のうち代表的なものの数要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 飲付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リ ードフレームとレジンとの密層性を良好にし、リ ードフレーム表面積増大によるリータパスの伴長 をはかって外部からの混気等の表達性異物の侵入 の単導体チェブへの到達時間を長くして、對止性 を向上させ、製品券金を製金し、信頼性を向上させることに成功した。

#### (実施例)

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2回は本発明リートフレームの要部斜視線、 第3回は第2回I-I線断面回を示す。

これら図において、4世半年休テァブを搭載するためのタブ、5はタブ吊りリード、6はリード、7は複数でなり、5はタブ吊りリード、6はリード、7は複数でなから、本発明である。本発明である。本発明では、カードフルートにあっては、これら図に例示するように、タブ吊りリットである。この突出部8の形成は、例えば、通常の方法により側面がフラットに形成されたロックを対してよりが変出するように形成してもよいから変出するように形成してもよいからでファクにより周端最から通宜を上下からでファクにより形成してもより形成となったが採用できる。

第4回は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂封止型半導体整置の断節固を示し、第4回に て、9は半導体チェブ、10はコネクタワイヤ、 11は樹脂対止体、12はリードフレームで半導 体チェブ9を搭載しているタブ13、及び半導体 チェブ9の内部配数をコネクタワイヤ10を用い て外部に引出するリード14にはそれぞれ央出部 15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チャブ9は、例えばシリコン単結晶基板より成り、周知の技術によって、このチャブ内には多数の回路業子が形成され、1つの回路機能を与えている。回路案子は例えば絶数ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスタ)から成り、これらの回路業子によって、例えば随理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミュウム(A8)細線により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエポキン樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5回は本発明の他の 実施例を示し、第2回に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、連宜の関係で横方向に 複数の鎌条の得部16を数けて成る実施例を示す。 近時、第4回に示すような機能お止型半導体装置 において、半導体チェブタが大形化し、リード14 の側離射止体11に組込まれる長さが次額に短 なってきている。そうすると、リード14を折曲 げて第4回に示すような折曲げリードとする場合、 折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンから スリップし、リードが開射対止体外部により スリップし、リードが開射対止体外部により スリップし、リードが開射対しに 別っぱり出されることになる。かかる課部16を 数けることにより、より一層、リードフレームと レジンとの密着性を向上し得る。

#### 〔劝 录〕

- (i) リードフレームの切断面に設付けを行ない、 毎面に突出帯を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、 リードフレームとレジンの密着性の向上が図られる。
- (2) 密着面積の増大により、レジン量が増大し、

#### 特別項69-195957(3)

かつ、偶国がフラットである場合に比較して、数が形成されているのでリータペスが長くなり、その結果外部からの半導体製造性(計量性)が向上の内部は、100円により製品場合を延伸し、側面性性の内により製品場合を延伸し、側面性を対し、側面性を対し、関連を対し、リードの一般を対し、リードの一般を対し、リードの一般を対し、リードの一般を対し、リードの一般を対し、リードの一般を対し、リートの音楽を行っている。ドッツの一人とレッシを開催の内上の関連を対し、半導体を観響を対し、半導体製造の名類性を向上し、半導体製造の名類性を向上し、半導体製造の名。

(5) リードフレームの何間に突出部を設けること に加えて、第5間に示すように、リードの上面に 課部を形成することにより、より一層リードフレ ームとレジンとの告着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に振し、リードがゆるん だり、複取倒止体の外部に突出したりすることを 防止できる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例に もとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施 例に観定されるものではなく、その要旨は逸歌し ない範囲で選々要更可能であることはいうまでも ない。

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面 全体化臭出器を設けた例を示したが、一部に突出 部を設けても差支えない。又前記実施例では非部 セリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。

#### [利用分野]

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのペッケージの他、フラットペッタタイプのペッケージ など他の複数対止担半導体機器にも適用することができ、複数対止型半導体機器会数に適用できる。 又電子部品のペッケージ技能にも適用できる。 思聞の簡単な説明

集1回はリードフレームの従来例を示す平面的、 第2回は本発明リードフレームの景部新規的、 第3回は第2回I-I兼断面回、

第4回は本発明リードフレームを使用して成る 機能対止超半導体装置の断面部、

箱 5 圏は本発明の他の実施例を示すリードフレ

ームの平面的である。

1…タブ、2…タブ吊りリード、3…リード、4…タブ、5…タブ吊がリード、6…リード、7

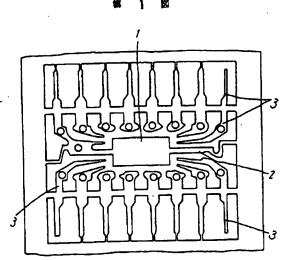
…情報穴、8 …突出事、9 …半導体テッツ、1 0 にないして いいり …コネクタワイヤ、1 1 … 養電対止体、1 2 … y

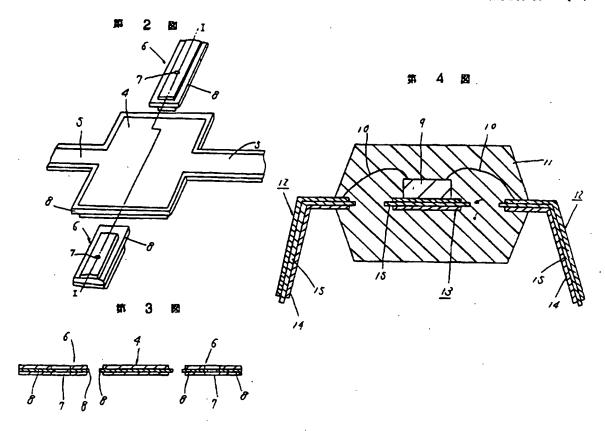
\_ PTP\_4 13... 67 14... 4 - F. 15

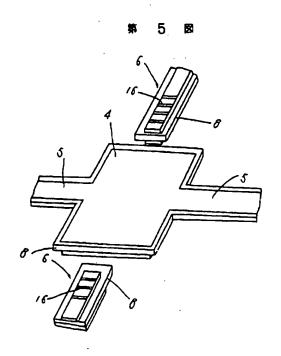
ードフレーム、18…タブ、14…リー 5、^^

…夾出部、16…青部。 へ。

代理人 弁理士 高 鲁 男 夫 🗓







## **Abstract of Japanese Patent Office Gazette**

No. H6-140563

### SEMICONDUCTOR DEVICE

Inventor:

Tsuji Masahiro

Applicant:

Rohm Co., Ltd.

Filed:

Oct. 23, 1992

Disclosed:

May 20, 1994

PURPOSE: To provide a semiconductor device prevented from generating the exfoliations of a resin from a die pad in a chain-reacting way and from generating the cracks of the resin, by improving the adhesiveness of the resin to the die pad in the corner of the die pad wherein the exfoliations are especially apt to occur, in the resin-sealed semiconductor device including a semiconductor chip die-bonded to the die pad.

CONSTITUTION: On each sidewall of a die pad 1, a recessed part 11 or a protruding part or the combination thereof is formed. Then, a resin 6 is made to eat into the recessed part 11 or to cover completely the protruding part, and concurrently, the effect of the difference between the thermal expansion coefficients of the resin 6 and the die pad 1 is made small by covering thin protruding parts 12 of the die pad 1 with the resin 6. Thereby, the adhesiveness of the resin 6 to the die pad 1 is improved.